

SU 180



Si-npn-Leistungstransistor für elektronische Vorschaltgeräte für Gasentladungslampen

Maße in mm und Anschlußbelegung

Masse ca. 22 g
Kollektor am
Gehäuse

Grenzwerte, gültig für den Umgebungstemperaturbereich

Kollektor-Basis-Spannung $I_E = 0$	U_{CBO}	1200	V
Kollektor-Emitter-Spannung $I_B = 0$	U_{CEO}	400	V
Kollektorstrom	I_C	2,5	A
Kollektorspitzenstrom	I_{CM}	5	A
Gesamtverlustleistung $\vartheta_c = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	35	W
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	+150	$^\circ\text{C}$

Kennwerte ($\vartheta_c = 25^\circ\text{C} - 5\text{ K}$)

		min.	typ	max.
Kollektor-Emitter-Reststrom $U_{CE} = 1200\text{ V}$	I_{CEX}			1,0 mA
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung $I_C = 2\text{ A}, I_B = 1,0\text{ A}$	U_{CEsat}			3,0 V
Basis-Emitter-Sättigungsspannung $I_C = 2\text{ A}, I_B = 1,0\text{ A}$	U_{BEsat}			1,5 V
Kollektor-Basis-Stromverhältnis $U_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 1\text{ A}$	h_{21E}	10		
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung $I_C = 100\text{ mA}$	$U_{(BR)CEO}$	400		V
Emitter-Basis-Durchbruchspannung $I_E = 10\text{ mA}$	$U_{(BR)EBO}$	6,0		V
Abfallzeit des Kollektorstromes $I_C = 1\text{ A}, I_B = -I_B = 0,2\text{ A}$	t_f			1,0 μs

Bestellbezeichnung: Transistor SU 180

Änderungen vorbehalten!



veb gleichrichterwerk
stahnsdorf
im veb kombinat mikroelektronik

DDR - 1533 Stahnsdorf, Ruhlsdorfer Weg
Telex 015220 Telefon 6-80

elektronik
export-import

Volkseigener Außenhandelsbetrieb
der Deutschen Demokratischen Republik
DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6
Haus der Elektroindustrie
Telefon: 21 80 - Telex: 114 721

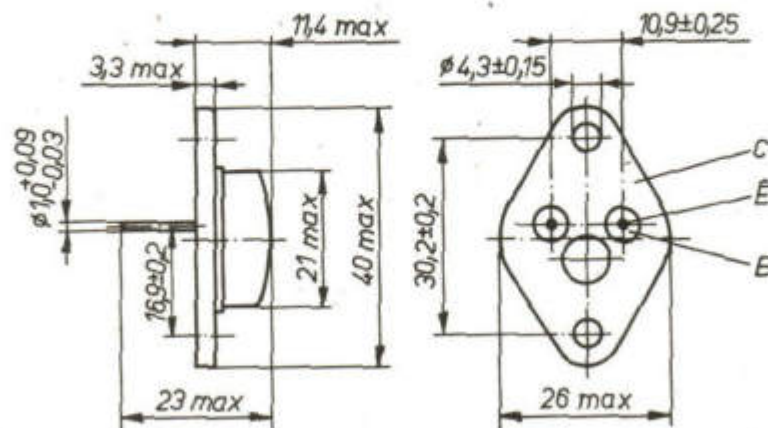
SU 180 / BU 204

n-p-n Si-power transistor for electronic series units for gaseous discharge lamps

Dimensions in mm and terminals

weight c. 22 g

Collector at case



Maximum ratings ($\vartheta_a = -25 \dots +125^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Collector-base-voltage

$I_E = 0$

U_{CBO} 1200 V

Collector-emitter voltage

$I_B = 0$

U_{CEO} 400 V

Collector current

I_C 2,5 A

Peak collector current

I_{CM} 5 A

Total power dissipation

$\vartheta_c \leq 25^\circ\text{C}$

P_{tot} 35 W

Junction temperature

ϑ_j +150 $^\circ\text{C}$

Characteristics ($\theta_c = 25^\circ\text{C} - 5\text{ K}$)

		min.	typ	max.
Collector-emitter cut-off current $U_{CE} = 1200\text{ V}$	I_{CEX}			1,0 mA
Collector-emitter saturation voltage $I_C = 2\text{ A}, I_B = 1,0\text{ A}$	U_{CEsat}			3,0 V
Base-emitter saturation voltage $I_C = 2\text{ A}, I_B = 1,0\text{ A}$	U_{BEsat}			1,5 V
Static value of the common-emitter forward current transfer ratio $U_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 1\text{ A}$	h_{21E}	10		
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 100\text{ mA}$	$U_{(BR)CEO}$	400		V
Emitter-base breakdown voltage $I_E = 10\text{ mA}$	$U_{(BR)EBO}$	6,0		V
Fall time $I_C = 1\text{ A}, I_B = -I_B = 0,2\text{ A}$	t_f			1,0 μs

Denotation for ordering: Transistor SU 180

Alteration reserved!

Ag 05/033/83



veb gleichrichterwerk stahnsdorf
im veb kombinat mikroelektronik

DDR - 1533 Stahnsdorf, Ruhlsdorfer Weg
Telefon 6 80 - Telex 015 220

elektronik
export-import

Volkseigener Außenhandelsbetrieb der
Deutschen Demokratischen Republik
DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6
Haus der Elektroindustrie, Telefon: 2180